

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МОНОКРИСТАЛЛОВ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$

Я. В. Копелевич, В. В. Леманов, П. П. Сырников

Исследованиям температурной зависимости удельного сопротивления монокристаллов $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ посвящен ряд работ [1-3]. Все такие исследования проводятся обычно на монокристаллах малых размеров (типичные размеры — $0.5 \times 0.5 \times 0.05$ мм) методом Монтгомери [4]. В настоящей работе поставлена задача на одном и том же образце провести измерения удельного сопротивления, используя методы Монтгомери и Ван-дер-По [5], а также изучить характер температурных зависимостей сопротивления и его анизотропию.

Монокристаллы $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ выращивались методом, аналогичным предложенному в [6]. Извлеченные из шихты монокристаллы отжигались

в атмосфере кислорода при 500°C . Измерение температурной зависимости сопротивления проводилось на образце с размерами $l_1 \times l_2 \times l_3 = 2.5 \times 2.3 \times 0.07$ мм (рис. 1) в интервале температур $4.2-300$ К на постоянном токе $1-20$ мА. Электрические контакты, сопротивление которых не превышало 1 Ом , приготавливались вживлением серебряной пасты при температуре 200°C . Площадь контакта составляла около 0.5 мм^2 .

Из температурных зависимостей «сопротивлений» $R_{12,34}(T)$ и

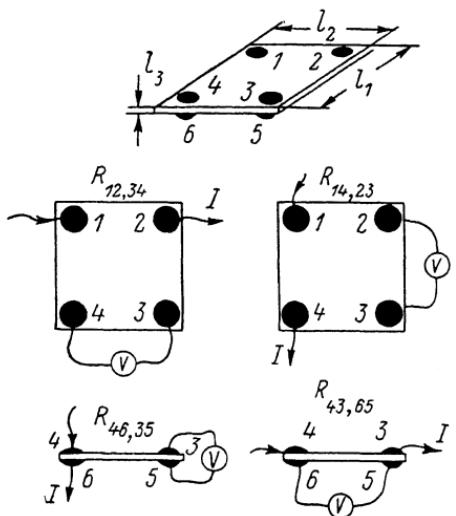


Рис. 1. Расположение измерительных контактов на образце.

$R_{14,23}(T)$ в двух взаимно перпендикулярных направлениях в плоскости (ab) (рис. 2) видно, что в обоих направлениях относительное изменение $R_{ik,lm}$ с температурой одинаково, т. е. $\Delta R_{12,34}(T)/R_{12,34} = \Delta R_{14,23}(T)/R_{14,23}$.

На основании этого равенства можно, согласно [7], сделать вывод об изотропии температурного коэффициента сопротивления $\text{TКС} = -(1/\rho)(dp/dT)$ в плоскости (ab) . Если предположить отсутствие анизотропии удельного сопротивления в этой плоскости ($\rho_1 = \rho_2 = \rho_{ab}$, где ρ_1 и ρ_2 — удельные сопротивления вдоль l_1 и l_2 соответственно), то ρ_{ab} , согласно Ван-дер-По [6], определяется по формуле

$$\rho_{ab} = \frac{\pi l_3}{2 \ln 2} (R_{12,34} + R_{14,23}) f(R_{12,34}/R_{14,23}), \quad (1)$$

где $f(R_{12,34}/R_{14,23})$ — корректирующая функция. Температурная зависимость сопротивления ρ_{ab} , рассчитанного по формуле (1), приведена на рис. 3, 1.

Для получения температурных зависимостей ρ_{ab} и ρ_c методом Монтгомери требуется измерение температурных зависимостей $R_{46,35}$ и $R_{43,65}$ (рис. 2). Расчет ρ_{ab} и ρ_c , выполненный в соответствии с [4], также основывался на предположении изотропии удельного сопротивления в плоскости (ab) . При расчете вместо l_2 бралась длина кратчайшего токового пути

между контактами 3, 4 или 5, 6, равная 0.6 мм. Температурные зависимости ρ_{ab} и ρ_c , вычисленные методом Монтгомери, приведены на рис. 3, 2, 3. Из этого рисунка видно, что температурная зависимость сопротивления носит металлический характер в плоскости (ab) и полупроводниковый вдоль оси c. Отношение сопротивлений ρ_c/ρ_{ab} (фактор анизотропии) увеличивается от 100 при 300 К до 600 при 100 К. Из рис. 3 следует также, что ρ_{ab} в нормальной фазе линейным образом меняется с температурой, причем при температуре около 180 К наблюдается четко выраженный излом зависимости $\rho_{ab}(T)$, т. е. ТКС претерпевает скачок.

Сравнивая температурные зависимости удельного сопротивления в плоскости (ab), полученные методами Ван-дер-По и Монтгомери, можно заключить, что их ход получается одинаковым для обоих методов. Абсо-

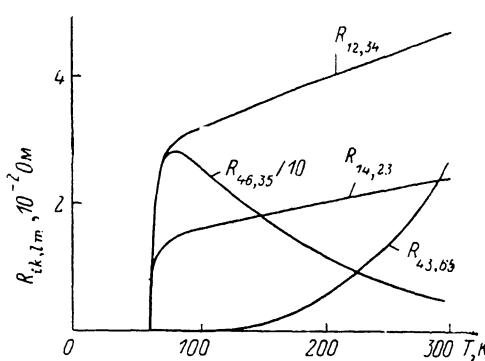


Рис. 2. Температурные зависимости $R_{ik, l, m}$.

Величина $R_{ik, l, m}$ определяется как отношение напряжения на контактах i, l, m к току, протекающему от i и k .

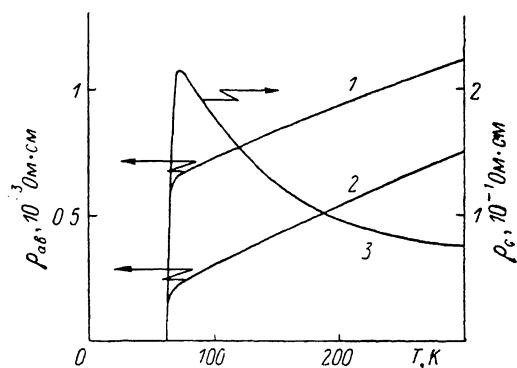


Рис. 3. Температурные зависимости удельного сопротивления в плоскости (ab) (1 — метод Ван-дер-По, 2 — метод Монтгомери) и вдоль оси c (3 — метод Монтгомери).

лютные же величины ρ_{ab} , полученные двумя методами, отличаются на 50 %. Такое различие может быть связано с неточностью контактов [8].

В [9] на основании экспериментальных данных [1] было показано, что температурная зависимость ρ описывается общей формулой

$$\rho = A/B + BT, \quad (2)$$

причем предполагается, что в плоскости (ab) ρ меняется с температурой по закону $\rho_{ab} = B_{ab}T$, а вдоль оси c — по закону $\rho_c = A_c/T$. Следующее из эксперимента [1] отличие от нуля коэффициентов A_{ab} и B_c связывается в [9] с погрешностью в геометрическом расположении контактов. Согласно [9], такое поведение $\rho(T)$ свидетельствует в пользу модели резонирующих валентных связей, предложенной Андерсоном [10] для объяснения механизма высокотемпературной сверхпроводимости. Из экспериментальных данных настоящей работы также следует, что $\rho(T)$ описывается формулой (2). Это же имеет место и для экспериментальных результатов работы [2]. Из данных настоящей работы и работ [1, 2] следует, что при уменьшении от образца к образцу фактора анизотропии ρ_c/ρ_{ab} от 600 до 80 (при 100 К) коэффициент A_c уменьшается от 18 до 1 Ом·см·К при маломенящемся коэффициенте B_{ab} (от $2.5 \cdot 10^{-6}$ до $1.4 \cdot 10^{-6}$ Ом·см·К $^{-1}$). При этом наблюдается тенденция к переходу от полупроводникового характера зависимости $\rho_c(T)$ к металлическому.

В заключение отметим, что скачок ТКС при 180 К наблюдался ранее и в керамических образцах $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ [11]. Анализ литературных данных показывает, что в монокристаллах $\text{RBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ ($\text{R} = \text{Y}, \text{Gd}, \text{Eu}$) также имеется скачок ТКС в области температур 170—200 К, что свидетельствует о наличии фазового перехода при этих температурах как в монокристаллах, так и в керамике.

Авторы благодарят В. А. Санину и Э. Б. Сонину за обсуждение результатов.

Л и т е р а т у р а

- [1] Tozer S. W., Kleinsasser A. W., Penney T. et al. Phys. Rev. Lett., 1987, vol. 59, N 15, p. 1768—1771.
- [2] Бураев Л. И., Винников Л. Я., Емельченко Г. А. и др. Письма в ЖЭТФ, 1988, т. 47, № 1, с. 50—52.
- [3] Макаренко И. Н., Никифоров Д. В., Быков А. Б. и др. Письма в ЖЭТФ, 1988, т. 47, № 1, с. 52—56.
- [4] Montgomery H. C. J. Appl. Phys., 1971, vol. 42, N 7, p. 2971—2975.
- [5] Van der Pauw L. J. Phil. Res. Rep., 1958, vol. 13, p. 1—9.
- [6] Schneemeyer L. F., Warczak J. V., Siegrist T. et al. Nature, 1987, vol. 328, N 6131, p. 601—603.
- [7] Wasscher J. D. Phil. Res. Rep. Suppl., 1969, N 8, p. 1—82.
- [8] Кучис Е. В. Методы исследования эффекта Холла. М.: Сов. радио, 1974. 328 с.
- [9] Anderson P. W., Zou Z. Phys. Rev. Lett., 1988, vol. 60, N 2, p. 132—135.
- [10] Anderson P. W. Science, 1987, vol. 235, N 4793, p. 1196—1198.
- [11] Копелевич Я. В., Леманов В. В., Сонин Э. Б., Сырников П. П. ФТТ, 1988, т. 30, № 8, с. 2432—2436.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
10 июня 1988 г.

УДК 539.67; 538.945²

Физика твердого тела, том 30, в. 10, 1988
Solid State Physics, vol. 30, № 10, 1988

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА И МОДУЛЯ ЮНГА В СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$

Ю. А. Буренков, В. И. Иванов, А. Б. Лебедев, Б. Л. Баскин,
Б. К. Кардашев, С. П. Никаноров, Ю. П. Степанов, В. Г. Флейшер,
В. Н. Варюхин, О. И. Дацко, А. В. Резников

В настоящее время уже имеется немало сведений о поведении модулей упругости и поглощения ультразвука в сверхпроводящих керамиках системы $\text{Y}-\text{Ba}-\text{Cu}-\text{O}$ [1—8]. В ряде работ обнаружены аномалии в поведении модуля и поглощения в районе температуры сверхпроводящего перехода T_c . Принципиальной, на наш взгляд, является работа [7], где показано, что аномальное поведение модуля является следствием крупно-зернистой структуры образцов, изготовленных по «сухой» технологии. В образце, приготовленном по «мокрой» технологии, где размер зерна на порядок меньше и форма зерен близка к сферической, аномалии на температурной зависимости модуля отсутствовали. Сверхпроводящий переход наблюдался и в том, и в другом случае. Авторы [7] сделали вывод, что аномалии на зависимости модуля Юнга от температуры $E(T)$, а также несовпадение кривых $E(T)$, измеренных при охлаждении и отогреве (температурный гистерезис), не связаны с наличием сверхпроводящего перехода, а обусловлены лишь структурным несовершенством керамики.

В настоящей работе исследуются температурные зависимости (в интервале 6—300 К) модуля Юнга E и логарифмического декремента колебаний δ на частоте около 100 кГц резонансным методом составного пьезоэлектрического вибратора. Этот метод имеет преимущество при исследовании внутреннего трения в керамиках по сравнению с высокочастотными эхо-импульсными методиками, так как на высоких частотах (порядка десятков МГц) существенный вклад в поглощение вносит механизм рассеяния ультразвука на неоднородностях [1, 4, 8]. Для регистрации декремента, амплитуды колебаний, резонансной частоты и электросопро-